

### 关键指标

输出频率: 30~42GHz  
 输出功率: 18dBm  
 输入功率: 0dBm  
 基波抑制: 80dBc  
 工作电压: +5V  
 工作电流: 110mA  
 芯片尺寸: 2.64mm×1.28mm×0.1mm

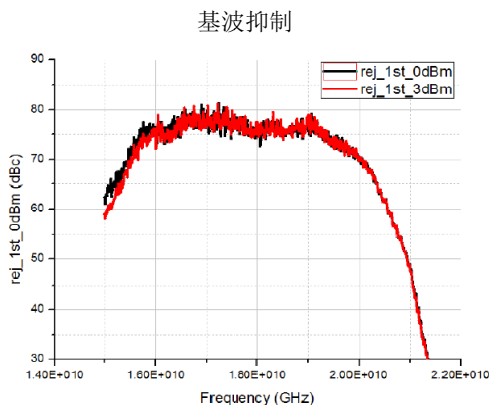
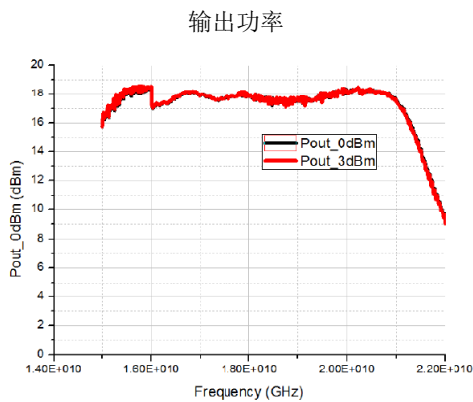
### 产品简介

HG129BA 是一款输出频率为 30~42GHz 的有源二倍频器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 基波抑制为 80dBc, 三次谐波抑制为 60dBc。

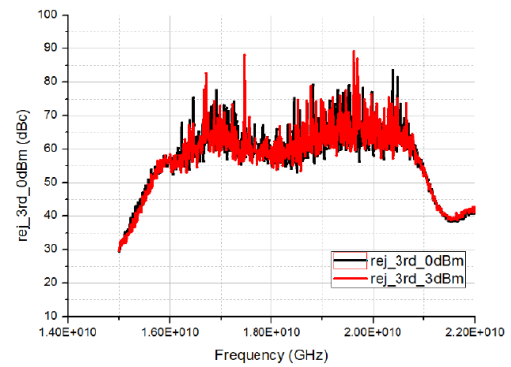
### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V, Pin=0dBm)

指标	最小值	典型值	最大值
输入频率(GHz)	15~21		
输出频率(GHz)	30~42		
输出功率(dBm)	-	18	-
基波抑制(dBc)	-	80	-
三次谐波抑制(dBc)	-	60	-

### 典型测试曲线



### 三次谐波抑制



### 外形和端口尺寸 (mm)



### 绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+10dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。